

Information



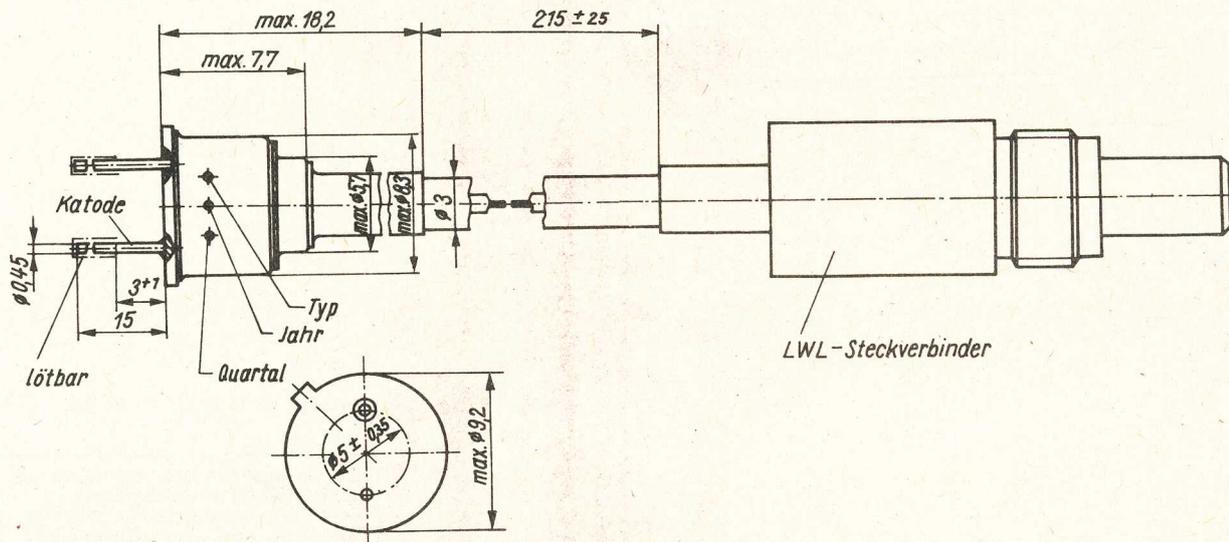
SP 109

Vorläufige technische Daten

1/84

Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

Die Si-pin-Fotodiode SP 109 ist insbesondere für den Einsatz in der Lichtleiternachrichtenübertragung (Teilnehmeranschlußbereich) bestimmt.



Masse: 30 g

Standard: TGL 55106

Redaktionsschluß Dezember 1983

Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Dunkelstrom		min.	typ.	max.	
bei $U_R = 20\text{ V}$	I_{RO}	-	0,05	2	nA
$E = 0$					

Spektrale

Empfindlichkeit					
bei $\lambda = 850\text{ nm}$	S	0,3	0,4	-	AW^{-1}
$U_R = 20\text{ V}$					

Anstiegszeit

bei $U_R = 20\text{ V}$	t_r	-	0,5	2	ns
$R_L = 50\ \Omega$					

Gesamtkapazität

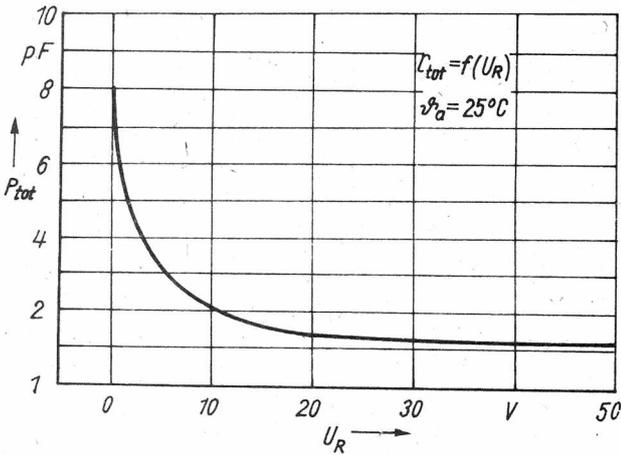
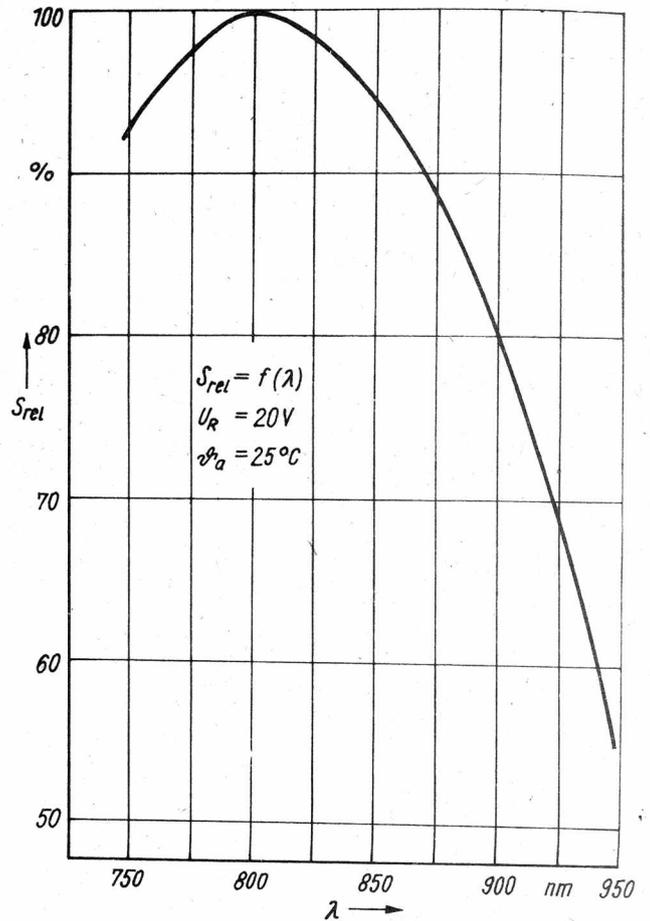
bei $f = 1\text{ MHz}$	C_{tot}	-	1	2	pF
------------------------	-----------	---	---	---	----

Grenzdaten

Gesamtverlustleistung $P_{tot} = 100\text{ mW}$

Betriebstemperaturbereich $\vartheta_a = -15\dots+55^\circ\text{C}$

Lagerungstemperaturbereich $\vartheta_s = -40\dots+55^\circ\text{C}$



BE-Nr. SP 109: 137 86 22 003 109019

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:
 veb applikationszentrum elektronik berlin
 im veb kombinat mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
 Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055